PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-150447

(43)Date of publication of application: 26.06.1991

(51)Int.Cl.

GO1N 21/17 G01N 33/20 G02B 21/14

(21)Application number: 01-289361

(71)Applicant:

NIPPON STEEL CORP

(22)Date of filing:

07.11.1989

(72)Inventor:

YOSHITOMI YASUNARI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR ANALYZING CRYSTAL STRUCTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To accurately and efficiency analyze a crystal structure by using the optical microscopic image for which a phase difference method is used as an original image and recognizing the grain boundary by binarization.

CONSTITUTION: The optical microscopic image for which the phase difference method is used is used as the original image and the grain boundary is regulated to be recognized by the binarization. A variable threshold method is used in the binarization to extract the grain boundary in addition to technology and further, the grain boundaries cut here and there are restored by using the remov al of isolated points, graphic expansion, graphic contraction, and formation of finer lines after the grain boundary is extracted by the binarization. The crystal structure analyzing apparatus consisting of the optical microscope which can produce the phase difference image and an image analyzing machine which makes the calculation to extract the grain boundary of the optical microscopic phase difference image of the crystal structure by the binarization is provided. The crystal structure is analyzed with the high accuracy and the high efficiency in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-150447

filnt.Cl.5

70代 理

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月26日

G 01 N 21/17 33/20 G 02 B 21/14 A 7458-2G M 7906-2G 8708-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

図発明の名称 結晶組織の解析方法及び装置

②特 願 平1-289361

②出 願 平1(1989)11月7日

⑩発明者 吉富

人

康成

福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1 新日本製鐵株式

會社第3技術研究所内

⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社

弁理士 大関 和夫

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

明 細 著

1. 発明の名称

結晶組織の解析方法及び装置

2.特許請求の範囲

- (1) 結晶組織を画像解析を用いて解析する方法 において、位相差法を用いた光学顕微鏡像を原画 像とし、粒界を二値化によって認識することを特 微とする結晶組織の解析方法。
- (2) 粒界を抽出する二値化において、可変しきい値法を用いることを特徴とする緯求項1記載の結品組織の解析方法。
- (3) 粒界を二値化により抽出した後、孤立点除去、図形の膨張、図形の収縮、細線化を用いて、切れ切れの粒界を修復することを特徴とする請求項1または2記載の結晶組織の解析方法。
- (4) 位相差像現出可能な光学顕微鏡と、結晶組織の光学顕微鏡位相差像の粒界を二値化によって抽出する計算を行う画像解析機からなることを特徴とする結晶組織の解析装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は結晶組織の解析方法及びそのための装置に関するものである。

〔従来の技術〕

結晶組織の解析には、一般に、(1)光学顕微鏡写真の各結晶粒を切り出し、重量を測定することによって各結晶粒の面積。粒径を求める方法、(2)光学顕微鏡像(又は写真)上に直線を描き、その直線を横切る粒界の数から平均粒径を求める方法、(3)単位面積内の結晶粒の数から結晶粒の平均面積、平均粒径を求める方法、(4)光学顕微鏡写真の粒界をマニュアルでトレースして、トレース像を画像解析機を用いて解析する方法等が行われている。

しかし、(1)、(4)の場合には、効率が極めて悪く、 (2)、(3)の場合には、結晶組織の平均情報だけで、 粒径分布、粒の形状等金属学的に重要な量が測定 できない等の問題がある。

一方、鉄鋼等材料中の結晶組織は、機械的性質。 磁気的性質に大きな影響を与える因子であり、結 晶組織を制御することは、材料科学の重要な学問 分野の1つとなっている。このような製品特性への影響に加えて、各材料の製造技術の中でも、結晶組織制御は重要な役割をもっている。例えば、方向性電磁制板は、二次再結晶現象を利用し、集充した、大型には、一次再結晶に先立つ一次再結晶はのよい。次の結晶粒の平均粒径、粒径分布が二次再結晶の良、不良、二次、再結晶粒の方位、製造の特性に影響を与えることが知られている。さらに結晶粒での結晶粒径が冷延再結晶後の集合組織に影響を与えることもよく知られている。

この様な背景をふまえ、近年精度、効率共に優れた結晶組織解析方法の開発が要望されてきた。 (発明が解決しようとする課題)

本発明は、結晶組織を精度良く、効率的に解析 することが難しいという問題点を解決する方法及 び装置を提供するものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、結晶組織を画像解析を用いて解析す

3

平均粒径を求める方法、(4)光学顕微鏡写真の粒界をマニュアルでトレースして、トレース像を画像解析機を用いて解析する方法が精度、効率、情報量等の点で問題があるところを、光学顕微鏡の位相差像を画像解析することによって結晶組織を高精度、高効率に解析することを目的とする。

る方法において、位相差法を用いた光学顕微鏡像を原画像とし、粒界を二値化によって認識する方法を提供するものである。また、上記技術に加えて、粒界を抽出する二値化において、可変しまた、位法を用いる方法を提供するものである。また、位化を用いて切れの粒界を修復するものである。また、位相差像現出可能な提供するものである。また、位相差像現出可能な光学顕微鏡と結晶組織の光学顕微鏡位相差像解析なる計算を行う
のなる結晶組織解析装置を提供するものである。

本発明は、鉄鋼等材料中の結晶組織を解析する際に、従来、一般に用いられていた(1)光学顕微鏡写真の各結晶粒を切り出し、重量を測定することによって各結晶粒の面積、粒径を求める方法、(2)光学顕微鏡像(又は写真)上に直線を描き、その直線を横切る粒界の数から平均粒径を求める方法、(3)単位面積内の結晶粒の数から結晶粒の平均面積

であるという新知見を得た。

次に本発明の構成要件の限定理由について述べる。

本発明において、結晶組織を画像解析を用いて解析する方法において、位相差法を用いた光学顕微鏡像を原画像とし、粒界を二値化によって認識すると規定したのは、位相差法が試料の凹凸を明暗のレベル差として現出させる方法であり、通常の腐食で現出しにくい小傾角粒界でもマトリックスと明暗差をつけることが可能であるため、二値化によって粒界を抽出するのに有利なためである。

光学顕微鏡像を画像解析機に入力する方法は特に限定しない。 光学顕微鏡写真をテレビカメラを用いて入力する方法、 光学顕微鏡から電気信号で直接画像解析機に入力する方法等いずれの方法でもよい。また、入力画像に対する濃淡画像の画像処理に関しては特に限定しないが、 シェーディング補正、 スムージング、 濃淡レベルの規格化等を行うことは、特度向上の点で好ましい。

また、上記発明に加えて、粒界を抽出する二値

さらに上記発明に加えて、粒界を二値化によって抽出した後、孤立点除去、図形の膨張、図形の 収縮、細線化を用いて、切れ切れの粒界を修復すると規定したのは、粒界を二値化によって抽出した後、 通常、 粒界は切れ切れになっており、 研磨 キズ、介在物等のノイズを含んだ面像になっているため、この二値化像をノイズを含まず、粒界が完全につながった画像へと変換するためには、孤 立点除去によるノイズ除去と、図形の影張による切れ切れの粒界の接続及びひき続く図形の収縮により粒界の幅を元に戻す処理と、粒径等の測定のために粒界幅を最小にする細線化が有効なためである。

さらに、二値化像を粒界のみの像へ修復する際、孤立点除去→図形の膨張→図形の収縮を一連の処理とし、孤立点除去のサイズ、図形の膨張の膨張幅(一図形の収縮の収縮幅)を小さい値から大きい値へ変えて、上記一連の処理を繰り返すことは特度向上の点でさらに好ましい。

細線化の方法については特に限定しない。 Hilditchの方法、鶴岡の方法、横井の方法、 Dentsch の方法、田村の方法等いずれの方法でも よい。

さらに、細線化後、孤立点除去、ヒゲ除去、欠 線連結等を適時行うことは精度向上の点でさらに 好ましい。

また、上記発明に加えて、位相差像現出可能な光学顕微鏡と、結晶組織の光学顕微鏡位相差像の

8

粒界を二値化によって抽出する計算を行う画像解析機からなる結晶組織の解析装置と規定したのは、本発明のアルゴリズムでの結晶組織解析を行うためには、上配ハードが必要なためである。また、上記規定以外の光学顕微鏡及び画像解析機の仕様については特に限定しない。

7

また、本発明のアルゴリズムに従って、結晶粒 界が認識された後、必要に応じて、粒界の切れて いる部分をマニュアルで結ぶことも、極めて高い 植度を必要とする場合は行ってもよい。その後週 常、結晶粒のサイズ(円相当径),真円度、周囲 長、縦横比等が測定される。

(実施例)

実施例 1

C:0.0010%、S1:3.25%、Mn:0.14%、S:0.006%、酸可溶性AL:0.026%、N:0.0081%を含有し、残部はPeおよび不可避的不純物からなる0.285mm厚の珪素鋼焼鈍板の断面を光学顕微鏡観察用に研磨した後ナイタールで腐食し、光学顕微鏡で位相差像を現出して、

テレビカメラより画像を画像解析機に入力し、第 1 図に示す画像解析フローを用いて、粒界像を作成した。原画像(位相差像)(a), 粒界像(b))を第2 図に示す。

事施例2

C:0.0015%、Si:3.28%、Mn:0.15%、Si:3.28%、Mn:0.15%、Si:3.28%、Mn:0.15%、Si:0.007%、酸可溶性Al:0.027%、N:0.0083%を含有し、酸可溶性Al:0.027%、N:0.0083%を含有し、酸可溶性Al:0.027%可避的不能物からなる0.285m厚の珪素類板の水学顕微鏡で位相整像を現出して、デリ盟を光学顕微鏡で位相整像を現出して、第1回に、カメラより画像を画像解析機に入力し、第1回したが、各結晶粒の直径(円相当直径)を測定したでの平均値と関準偏差を計算した。また、社較のマームの直径の平均値と関準偏差をい値指定のでは、また、地位に、また、地域によりには、大いでは、大いの直径の平均値と関準にある。また、地域に各結晶粒の直径の平均値と関準に各結晶粒の直径の平均値とでも、同様に各結晶粒の直径の平均値とでも、同様に各結晶粒の直径の平均値を加出し、同様に各結晶粒の直径の平均値

と標準偏差を測定した。上記測定結果を第1表に 示す。

第 1 ま

解析法	平均直径 (μm)	直径の 標準偏差 (μm.)	備考
本 発 明 法	2 1. 5	1 0. 0	本発明
トレース法	2 1. 0	9. 7	比較例
マニュアル しきい値指定法	2 9. 3	1 5. 1	比较例

実施例3

C:0.0011%、Si:3.21%、Mn:0.14%、S:0.028%、N:0.007%、酸可溶性AI:0.028%、N:0.0078%を含有し、残部Feおよび不可避的不純物からなる0.285ma厚の珪素網板の断面を光学顕微鏡観察用に研磨した後ナイタールで腐食し、光学顕微鏡で位相差像を現出して、テレビカメラより画像を画像解析機に入力し、第1図に示す画像解析フローを用いて粒界像を作成した後、各結晶粒の直径(円相当直径)を測定し、粒

径分布を計算した。また、比較のため、画像解析機に入力した位相差像の粒界をマニュアルでトレースし、トレース像で同様に各結晶粒の直径を測定し、粒径分布を計算した。本発明法、トレース法での結果を第3図に示す。

(発明の効果)

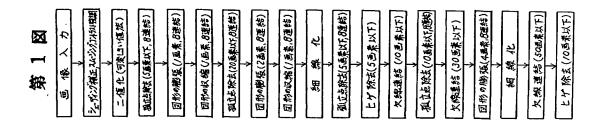
以上のとおり、本発明によれば、鉄鋼等材料の 機械的性質、磁気的性質に大きな影響を与え、か つ各材料の製造技術の中でも重要な金属学的因子 である結晶組織における結晶粒のサイズ、分布状 態等の高確度な解析が効率よく行えるため、その 学問的、工業的効果は大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、結晶組織の光学顕微鏡位相差像を原画像として、粒界像を得るための画像解析フローであり、第2図は、は結晶組織の光学顕微鏡位相差像と、(b)本発明法を用いて得られる粒界像の例を示す結晶組織の光学顕微鏡写真図であり、第3図は、本発明法及びトレース法で得られた結晶粒径分布の例である。

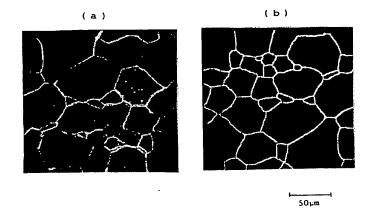
1 1

1 2

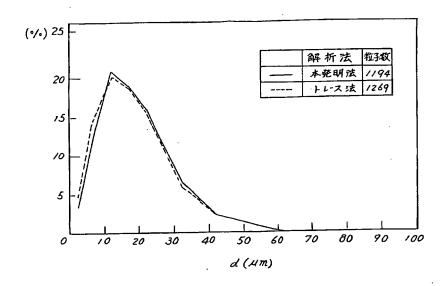


特開平 3-150447(5)

第2図



第 3 図



手続補正售 (自発)

平成 2 年 5 月 28 日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殿

1. 事件の表示

平成1年特許顯第289361号

2、発明の名称

結晶組織の解析方法及び装置

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代川区大手町二丁目6番3号(665)新日本製鐵株式會社 代表者 山 本 全 作

4. 代 理 人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 九ノ内ピルギング374区 TEL 201-48 弁理士(6480) 大 関 和 共変

月

- 5. 補正命令の日付 平成 年
- 6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄。図面の簡単な 説明の棚及び図面 - _

7. 補正の内容

方式(第)

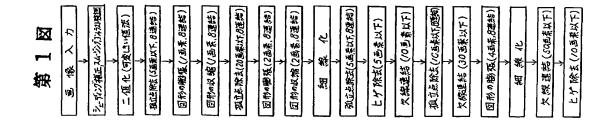
1

(1) 明細 俳 5 頁 8 行 「広汎」を「広範」に補正す

(2) 同 1 2 頁 1 8 行 「光学顕微鏡写真図」を | 写 真図」に補正する。

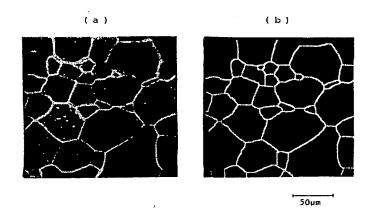
(3) 第1 図及び第2 図を別紙の通り夫々補正する。

2



特開平 3-150447(7)

第200



THIS PAGE BLANK (USPTA